# Numerical simulation of tabletop THz FEL amplifier

Keisuke Higashimura, Satoshi Ueda, Kyouhei Yoshida, Ryota Kinjo, Mahmoud A.Bakr, Taro Sonobe, Toshiteru Kii, Kai Masuda, Hideaki Ohgaki, Institute of Advanced Energy, Kyoto University Cokesho, Liii, Kyoto, 611,0011

Gokasho, Uji, Kyoto, 611-0011

#### Abstract

At Institute of Advanced Energy, Kyoto University, we have studied on a tabletop THz FEL amplifier by using photocathode RF gun. Injection-seeded THz-wave parametric generator is planned to be used for FEL seeding. Concerning about the combination between a long wavelength FEL and a short bunch electron beam, the phenomenon that the electron beam slips from the FEL light and the interaction between the electron beam and the FEL light stops before FEL saturation was confirmed from numerical simulation. As FEL not being saturated under this condition, unstable FEL operation originated from unstable electron beam and/or seed light could be predicted. Fluctuation of the

FEL power was calculated by beam tracking simulation code Parmela and 3-D FEL gain simulation code GENESIS1.3. We found that FEL with peak power 5.1kW and pulse energy 0.10µJ can be expected from this amplifier.

Discussion about design of FEL amplifier and electron beam property which is more suitable for users is reported to achieve FEL power stability.

# テーブルトップTHz FEL増幅装置の数値シミュレーション

# 1. はじめに

京都大学エネルギー理工学研究所では、光陰極型 高周波電子銃より発生させた高輝度電子ビームを用 いたテーブルトップサイズTHz FEL増幅装置の設計 を行っている。長波長FEL発振においてslippageの及 ぼす影響を含め、増幅器のFEL出力計算を行い設計 の評価を行った。その上でFEL出力安定化用の対策 として、発振に適した装置設計と電子ビームに関す る考察を行ったので報告を行う。

#### 2. FEL 增幅装置

今回検討するFEL増幅装置の概念図を図1に示す。 今回のFEL出力計算はシミュレーションコード PARMELA<sup>[1]</sup>による電子銃からアンジュレータ入口 までのビーム軌道計算とシミュレーションコード GENESIS 1.3<sup>[2]</sup>によるアンジュレータ中のFEL出力計 算に分けておこなった。BNLタイプ1.6空洞型光陰 極型高周波電子銃<sup>[3][4]</sup>によって高輝度電子ビームを 発生させ、ソレノイド磁気レンズを用いて電子ビー ムに収束をかける。電子ビームは波長可変である光 注入型 THz 波パラメトリック発生器<sup>[5]</sup>(injectionseeded THz-wave parametric generator : is-TPG)より発 振したシード光と同期させて短周期アンジュレータ に入射してFEL増幅をおこなう事を計画している。 is-TPGとはNd:Yagレーザーと半導体レーザーをそれ ぞれポンプレーザーとアイドラーレーザーとして MgO:LiNbO3結晶に入射させる、THz光のパラメト リック発生装置である。この際装置の小型化をはか る為、Nd:Yagレーザーをビームスプリッターに通し、 光陰極励起用レーザーとis-TPGポンプレーザー双方 の役割を担わせる予定である。is-TPGより発生した

シード光はTHz波用レンズで集光させホローミラー により反射させることで電子ビームの軸軌道と一致 させる。装置全体で2m×4mのテーブルトップサイ ズとすることを目標としている。





#### 3. ビーム軌道計算

粒子シミュレーションPARMELA<sup>[1]</sup>で電子ビーム の電子銃における発生並びにソレノイド磁気レンズ における収束を計算した。電子銃に用いる空洞はS バンド (2856MHz)の1.6 セル空洞で、電界強度 100MV/mまで使用可能と報告されている<sup>[6]</sup>。陰極か らのアンジュレータ入口までのビーム移動距離は 0.8mとする。光陰極に入射するレーザーのパルス長 と陰極上での半径はそれぞれ10psと0.7mmとして計 算に用いた。FEL発振に適したパラメータを探索し た結果<sup>[7]</sup>、レーザー入射位相を40°、空洞内電界強 度を70MV/mに今回の計算では固定した。ソレノイ ドはエミッタンス補償に用いるものであるが、磁気 レンズとして用いることで機器を増やすことなく電 子ビームの収束が可能となる。磁場は2.5kGまでの 出力が可能であり<sup>[3]</sup>、2.0kG以上の磁場をかけるこ とで電子ビームの収束が行えることが計算より確認 されている<sup>[7]</sup>。バンチ電荷が1nC、ソレノイド磁場 が2.1kGとして計算した場合、アンジュレータ入口 での電子ビームのパルス長、ピーク電流、エネル ギーはそれぞれ3.47ps、115A、6.25MeVと求められ た。

### 4. FEL出力計算手法

アンジュレータ中でのFEL出力計算は3-D FELシ ミュレーションコードGENESIS1.3<sup>[2]</sup>により行った。 計算に用いたビームパラメータはソレノイド磁場 2.1kGの条件下においてPARMELAで求めた電子ビー ムのものを用いた。陰極から0.8mの距離にあるアン ジュレータ入口での、バンチ電荷1.0nCをもつ電子 ビームのパラメータを表1に示す。シード光は出力 0.20Wとし、アンジュレータ入口で半径3.5mmの ビーム焦点をもつものとした。また表2にはアン ジュレータのパラメータを示す。

アンジュレータのギャップと周期に対してピーク 磁場は次の式によって表される。

$$B_{\max} = 3.33 \exp\left[-\frac{Gap}{\lambda_u} (5.47 - 1.8 \frac{Gap}{\lambda_u})\right] \quad (1)$$

これを変形すると

$$\frac{1.8}{\lambda_u} Gap^2 - 5.47 Gap - \lambda_u \ln(\frac{B_{\text{max}}}{3.33}) = 0$$
 (2)

となり期待されるピーク磁場をもつためにアンジュ レータが必要なギャップを計算することができる。 周期 $\lambda_u$ =20.0mm、ピーク磁場 $B_{max=1.0T}$ として計算を 行うと必要なギャップは4.8mmであると求められた。 FELはアンジュレータ中を一辺4.8mmの正方導波管 をすすむものと仮定した。

電子ビームのパルス長が1mm程であるため、FEL 計算にはslippageの影響も含めた計算を行うtimedependentシミュレーションをGENESIS 1.3で行った。

表]:電子ビームハラ	フメ	ータ
------------	----	----

規格化エミッタンス(x,rms)	1.77πmm-mrad
規格化エミッタンス(y,rms)	1.63πmm-mrad
エネルギー幅	0.80%
x 方向ビーム半径(rms)	0.74mm
y 方向ビーム半径(rms)	0.72mm
twiss parameter $\alpha_x$	1.77
twiss parameter $\alpha_v$	1.95
ピーク電流	115A
ビームエネルギー	6.25MeV
パルス長(rms)	$3.47 \text{ps} (L_b=1.04 \text{mm})$
表2:アンジュレータ	パラメータ
周期 $\lambda_{ m u}$	20.0mm
周期数 N <sub>u</sub>	125
ピーク磁場 B <sub>max</sub>	1.0T

|--|

#### 5. 考察

図2にアンジュレータ出口におけるバンチ電荷 1.0nCをもつ電子ビーム、及びバンチ電荷0.8nC、 1.0nC、1.2nCをもつ電子ビームに対し得られる波長 185µmのFELパルスの時間構造を示す。バンチ電荷 1.0nCの電子ビームでFEL発振を行った場合ピーク出 力5.1kW、パルス全体で0.10µJの出力をもつFELが得 られることが計算より求められた。またbunching factorが増加傾向にあり飽和に達していなかったた め、FEL飽和には125周期のアンジュレータでは達 していないとみなすことができる。ただしアンジュ レータ周期数増加は装置のさらなる延長を必要とし 2m×4mに増幅装置全体が収まらない可能性が出て くるため、アンジュレータ周期125以上での装置設 計を考えないこととする。

FEL飽和に達していないため、FELがどの程度安 定した出力で発振できるか確認する必要がある。図 2よりバンチ電荷が1.0nCが0.8nCへと減少してもFEL パルスには大きな変化は確認できず、安定したFEL 発振が可能であった。逆にバンチ電荷が1.2nCに増 加した場合、FELピーク出力が著しく減少する計算 結果が得られた。よって安定してFEL発振が可能で ある電子ビームパラメータの領域は存在するものの、 過度の電荷によりFEL出力が減少すると考えられる ことができる。図3にバンチ電荷0.8nC、1.0nC、 1.2nCをもつ電子ビームのx方向半径が発展する計算 結果を示す。バンチ電荷増大による電子間の空間電 荷効果増大から、電子ビーム半径はバンチ電荷増加 に伴い拡大していることが確認できた。安定した FEL発振が可能な0.8nC~1.0nCでは電荷量が減少し た場合、ピーク電流が減少する影響に対して空間電 荷効果減少によるビーム収束が補償となって出力が 安定すると考えられる。しかしFEL出力が下がる 1.2nCでは電荷量が増大し、ビーム収束力の悪化に よるロスがピーク電流増大によるゲインを上回った ものと考えられる。

現在の設計においてもFEL出力安定領域は存在す るものの、FELゲインが増加し飽和に達して出力が 安定するようFEL増幅装置の再設計を行うことも必 要であると考えられる。FEL飽和に達していない理 由として電子ビームがFELよりslipした影響(slippage) があげられる。電子ビームはアンジュレータ1周期 につき1FEL波長分の長さFELよりスリップする。電 子ビームのパルス長が1.04mmでFEL波長が185µmで あった時、電子ビームとFELは数周期相互作用をお こした後slipすることになる。そのためFEL飽和に 達するためにはアンジュレータ1周期での相互作用 で得るゲインを増大させることが有効であると考え られる。



#### 6. 装置設計

1周期での電子ビームとFELの相互作用で得るゲ インを増大させ、FEL飽和に近付けるために、ソレ ノイド磁気レンズの磁場を2.1kGから2.3kGに増加さ せ、より強い収束をかけた電子ビームをPARMELA において計算した。電子ビームに強い収束をかけた 場合、収束部以外でのビーム半径は急速に発散する ためアンジュレータ中であってもFELゲインも急減 するものと考えられる。よってアンジュレータ周期 数を減らし、アンジュレータ中では電子ビーム半径 を短く保ち1周期あたり強い相互作用を起こすよう に装置を再設計した。

ソレノイド磁気レンズの磁場を2.3kGとし、アン ジュレータ周期数Nu=80とした条件の元でバンチ電 荷 1.0nC の 電子 ビームが発振する FEL 出力を GENESIS 1.3において計算した。ソレノイド磁気レ ンズ磁場の変化に対するアンジュレータ出口におけ るFELパルス時間構造を図4に示す。ソレノイド磁 場が2.3kGの時に、ピーク出力350kW、パルス全体 で4.1µJに達する波長185µmのFELパルスを発生する ことが計算より得られた。ソレノイド磁場が2.1kG の時と比較してFELのピーク出力が2桁増大したこ とからFEL飽和に近づいたと考えられる。その反面、 装置の現設計では電子ビーム半径の発散によりアン ジュレータ周期数を増やしてもこれ以上のゲインは 望めないため、例えばアンジュレータ間に四重極電 磁石を挟んだFODO構造<sup>[8]</sup>としてアンジュレータ周 期数を増やす必要があると考えられる。



図4:ソレノイド磁気レンズ磁場の変化に対する アンジュレータ出口におけるFELパルス時間構造

## 7. まとめ

テーブルトップTHz FEL増幅装置の数値シミュ レーションを行った結果、ピーク出力5.1kW、パル ス全体で0.10µJの出力をもつFELが得られることが 計算より求められた。slippageによりFEL飽和に達し ないという結果が得られたものの、安定的にFEL発 振が可能なバンチ電荷領域が存在することが計算よ り求められた。またより強いソレノイド磁場による 電子ビーム収束を行いアンジュレータ1周期におけ るゲイン増大によって飽和を達成するため装置の再 設計を行った。アンジュレータ周期数を減らし、ソ レノイド磁場が2.3kGの時ピーク出力350kW、パル ス全体4.1µJに増大したFELパルスを発振する計算結 果が得られた。

アンジュレータ中を電子ビームが収束状態で進行 させることにより、大きなゲインをFELが受け続け ることになり最終的には飽和に達する可能性もある と考えられる。そのため今後は小型の四重極電磁石 を挟んだFODO構造のアンジュレータを用いた設計 も考えてFEL発振のシミュレーションを行う予定で ある。

## 参考文献

[1] L.M. Young, et al., PARMELA, LA-UR-96-1835, (2001)

[2] S. Reiche, Nucl. Instr. and Meth. 429 (1999) 242

[3] F.Sakai, et al., Japanese Journal of Applied Physics, vol. 41, pp.1589 (2002)

[4] R. Kuroda, et al., International Journal of Modern Physics B, vol. 21, pp.488 (2007)

[5] K. Kawase, et al., Applied Physic Letters, vol. 80, no. 2, pp. 195 (2002)

[6] J.Yang, et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 491, pp.15 (2002)

[7] K.Higashimura, et al., "Conceptual design study on a tabletop seeded-THz FEL", 第5回日本加速器学会年会 Proceedings, (2008)

[8] Y.U.Jeong, et al., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A 475, pp.47 (2001)